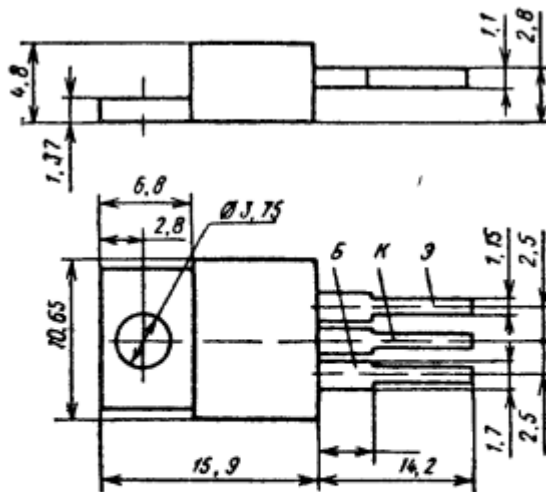


КТ835 (А, Б)



КТ835 (А, Б)

Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:	
при $U_{кз} = 1$ В, $I_{к} = 1$ А для КТ835А, не менее	25
при $U_{кз} = 5$ В, $I_{к} = 2$ А для КТ835Б	10 100
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ, не менее	
	1 МГц
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более:	
при $I_{к} = 1$ А, $I_{в} = 0,2$ А для КТ835А	0,35 В
при $I_{к} = 3$ А, $I_{в} = 0,6$ А для КТ835Б	2,5 В
Обратный ток коллектора при $U_{кз} = U_{кз, макс}$:	
КТ835А	100 мкА
КТ835Б	150 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кз} = 30$ В, не более	
	800 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:	
КТ835А	30 В
КТ835Б	45 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер	
	30 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	
	4 В
Постоянный ток коллектора:	
КТ835А	3 А
КТ835Б	7,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность при $T_{ж} = -40... + 25$ °С	
	25 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	
	+125 °С
Температура окружающей среды	
	-40 °С $T_{ж} =$ +100 °С